

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-237471

(P2001-237471A)

(43)公開日 平成13年8月31日 (2001.8.31)

(51)Int.Cl.

H 01 L 43/08

G 11 B 5/39

H 01 F 10/08

41/18

H 01 L 43/12

識別記号

PI

テ-73-1(参考)

H 01 L 43/08

Z 5 D 0 3 4

G 11 B 5/39

5 E 0 4 9

H 01 F 10/08

41/18

H 01 L 43/12

審査請求 有 請求項の数40 OL (全 23 頁)

(21)出願番号

特願2000-57908(P2000-57908)

(22)出願日

平成12年3月2日(2000.3.2)

(31)優先権主張番号 特願平11-54077

(32)優先日 平成11年3月2日(1999.3.2)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平11-83305

(32)優先日 平成11年3月26日(1999.3.26)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平11-135280

(32)優先日 平成11年5月17日(1999.5.17)

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 植間 博

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 杉田 康成

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 100078282

弁理士 山本 秀策

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 磁気抵抗効果素子とその製造方法、磁気抵抗効果型ヘッド、磁気記録装置、磁気抵抗効果メモリ
素子

(57)【要約】

【課題】 热的安定性と高MR比とを有する磁気抵抗効果素子を提供する。

【解決手段】 磁気抵抗効果素子は、外部磁界により容易に磁化回転する自由層と、第1非磁性層と、該第1非磁性層に対して該自由層の反対側に設けられ、該外部磁界により容易には磁化回転しない第1固定層とを含み、該第1固定層と該自由層との少なくとも一方は、該第1非磁性層と接する第1金属磁性膜と、第1酸化物磁性膜とを含む。

